

## 5 НОВЫЕ СЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

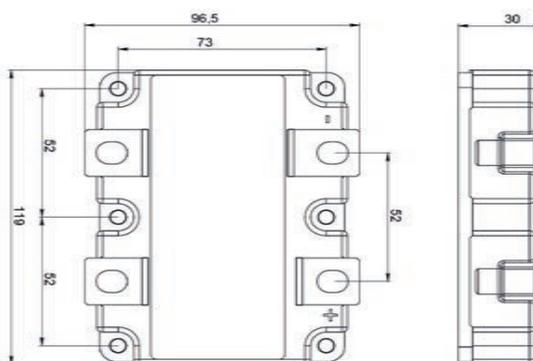
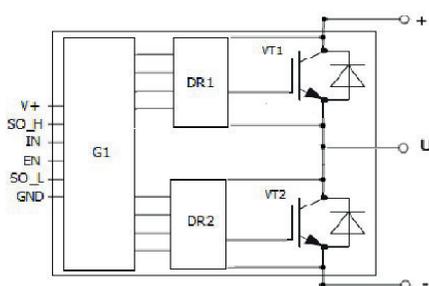
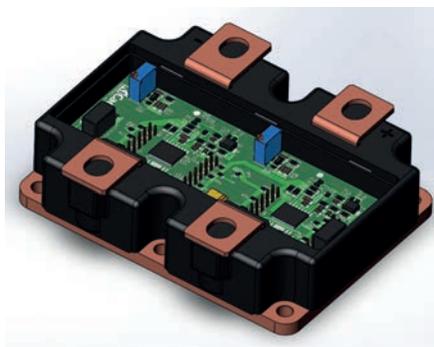
### 5.21 Модуль полупроводниковый силовой на основе IGBT и диодов Шоттки МТКИ2-600-2 УХЛЗ • ДФЛК.435700.001ТУ

Модуль предназначен для работы в установках оснащенных бесколлекторными двигателями как, в режиме силового инвертора, так и в режиме выпрямителя.

Модуль состоит из транзисторов с малыми статическими потерями и диодов Шоттки с низким падением, что позволяет получить высокие характеристики в режиме инвертора и выпрямителя.

Модуль оснащен интегрированным драйвером силовых ключей, установленным непосредственно в конструктив модуля.

Предусмотрена установка термистора для контроля температуры основания модуля.



Параметр	Буквенное обозначение	Значение
1	2	3
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В	$U_{КЭ\ max}$	200
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{К\ max}$	600 <sup>1</sup>
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А	$I_{К(и)\ max}$	1800 <sup>1</sup>
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ( $I_{К} = 600\ A$ ), В	$U_{кэ\ нас}$	2.0 <sup>1</sup>
Начальный ток коллектора ( $U_{кэ} = 200\ В$ ), А	$I_{нач}$	100
Постоянное прямое напряжение встроенного диода, В ( $I_{пр} = 600\ A$ )	$U_{пр}$	$\leq 0,95^1$
Максимально допустимый постоянный ток диода, А	$I_{ЭК\ max}$	600 <sup>1,2</sup>
Максимально допустимый импульсный ток диода, А	$I_{ЭК(и)\ max}$	1800
Максимально допустимое напряжение управляющей части, В	$U_{п.\ max}$	5,5
Входное пороговое напряжение высокого логического уровня, В	$U_{пор.вх.в.}$	2,2
Входное пороговое напряжение низкого логического уровня, В	$U_{пор.вх.н.}$	1,2
Тепловое сопротивление переход-корпус, °С/Вт	$R_{Т\ пер-корп.}$	0,2
Примечания		
1. При температуре корпуса 25°C.		
2. При температуре корпуса -60,85°C.		